PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-307393

(43) Date of publication of application: 17.11.1998

(51)Int.CI.

G03F 7/038 C08L 79/08 C09D179/08 G03F 7/004 H01L 21/027

(21)Application number: 09-117270

(71)Applicant: ASAHI CHEM IND CO LTD

(22)Date of filing:

07.05.1997

(72)Inventor: TAKAHASHI HIDEAKI

YOKOTA KANICHI

(54) PHOTOSENSITIVE COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a photosensitive composition capable of developing with alkali and superior in sensitivity and resolution.

SOLUTION: This photosensitive composition contains (A) a polyamide acid derivative having a structural unit represented by the formula in which R1 is a tetravalent organic group, R2 is a divalent organic group and each of R3 and R4 is a univalent organic group or a hydroxyl group and at least one of them is an organic group having ≥1 hydroxyl group combining with an aromatic ring, (B) a compound producing an acid by irradiating with radiation and (C) a compound capable of cross-linking the polyamide acid derivative (A) by the action of the acid.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

28.04.2004

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

(19)日本国特許广(JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許山蘇公開番号

特開平10-307393

(43)公開日 平成10年(1998)11月17日

C 0 8 L 79/08 C 0 C 0 9 D 179/08 C 0 G 0 3 F 7/004 5 0 3 C 0 H 0 1 L 21/027 H 0	3 F 7/038 504 8 L 79/08
C 0 9 D 1/9/08 C 0 G 0 3 F 7/004 5 0 3 C 0 H 0 1 L 21/027 H 0	9 D 179/08 Z 3 F 7/004 5 0 3 Z 1 L 21/30 5 0 2 R
G03F 7/004 503 C0 H01L 21/027 H0	3 F 7/004 5 0 3 Z 1 L 21/30 5 0 2 R
H01L 21/027 H0	1 L 21/30 5 0 2 R
· 審	
	空請求 未請求 請求項の数3 OL (全 12 頁)
(21) 川爾米县 佐爾亚9 - 117270 (71)	
(1) Higher 3 111210 (11)	出願人 000000033
	旭化成工業株式会社
(22) 川顧日 平成9年(1997) 5月7日	大阪府大阪市北区堂島浜1丁目2番6号
. (72)	発明者 高橋 秀明
	静岡県富士市鮫島2番地の1 旭化成工業
	株式会社内
(72)	発明者 横田 完一
	東京都千代田区有楽町1丁目1番2号 旭
	化成工業株式会社內

(54) 【発明の名称】 感光性組成物

(57)【要約】

【課題】 アルカリ現像が可能で、かつ、感度、解像性 に優れた感光性組成物を提供する。

【解決手段】 (A)下記一般式(1)の構造単位を有 するポリアミド酸誘導体、

【化1】

$$\begin{bmatrix}
0 & 0 \\
0 & 1 \\
C & -NH - R^2 - NH
\end{bmatrix}$$
(1)

- (B) 放射線照射により酸を発生する化合物、及び
- (C)酸の作用により(A)のポリアミド酸誘導体を架 橋し得る化合物を含有することを特徴とする感光性組成 物を製造する。

特開平10-307393

【特許請求の範囲】

【請求項1】 (A)下記一般式(1)で表される構造 単位を有するポリアミド酸誘導体100重量部、

【化1】

$$\begin{bmatrix}
0 & 0 \\
1 & 1 \\
C & R^{3} - C & R^{4} \\
0 & 0
\end{bmatrix}$$
(1)

(式中、R¹:四価の有機基、R²:二価の有機基、R³、R⁴:一価の有機基又は水酸基を示し、そのうち少なくとも一方は芳香環に結合した水酸基1個以上を有する有機基を示す。)、(B)放射線照射により酸を発生する化合物0.5~20重量部、(C)酸の作用により上記一般式(1)で表される構造単位を有するポリアミド酸誘導体を架橋し得る化合物3~40重量部を含有することを特徴とする感光性組成物。

【請求項2】(A)下記一般式(1)で表される構造単位を有するポリアミド酸誘導体と下記一般式(2)で表される構造単位を有するポリアミド酸の混合物100重量部、

【化2】

$$\begin{bmatrix}
0 & 0 \\
0 & 1 \\
C & R^{3} - C \\
0 & 0
\end{bmatrix} = R^{1} - R^{2} - R^{4}$$
(1)

(式中、R¹:四価の有機基、R²:二価の有機基、 R³、R⁴:一価の有機基又は水酸基を示し、そのうち少 なくとも一方は芳香環に結合した水酸基 1 個以上を有す る有機基を示す。)、

【化3】

$$\begin{bmatrix}
0 & 0 \\
0 & 1 \\
C & NH - R^6 - NH
\end{bmatrix}$$
(2)

(式中R5は四価の有機基、R6は二価の有機基を示す。)

(B) 放射線照射により酸を発生する化合物0.5~20重量部、(C)酸の作用により上記一般式(1)で表される構造単位を有するポリアミド酸誘導体を架橋し得る化合物3~40重量部、を含有することを特徴とする感光性組成物。

【請求項3】(A)下記一般式(1)および下記一般式(2)で表される構造単位を含む共重合体構造を有するポリアミド酸誘導体100重量部、

【化4】

$$\begin{array}{c|c}
 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0 \\
 & 0 & 0
\end{array}$$
(1)

(式中、R¹:四価の有機基、R²:二価の有機基、R³、R⁴:一価の有機基又は水酸基を示し、そのうち少なくとも一方は芳香環に結合した水酸基1個以上を有する有機基を示す。)、

【化5】

$$\begin{bmatrix}
0 & 0 \\
R & C \\
HO - C & C - NH - R^{6} - NH
\end{bmatrix}$$
(2)

(式中R⁵は四価の有機基、R⁶は二価の有機基を示す。)

(B)放射線照射により酸を発生する化合物0.5~2 0重量部、(C)酸の作用により上記一般式(1)で表される構造単位を有するポリアミド酸誘導体を架橋し得る化合物3~40重量部、を含有することを特徴とする感光性組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術的分野】本発明は、電子部品の絶縁 材料や半導体装置におけるパッシベーション膜、バッファーコート膜、層間絶縁膜などに用いられるポリイミド 膜のパターンを形成するための感光性樹脂組成物に関する。

[0002]

【従来の技術】ポリイミド樹脂は、優れた耐熱性と電気特性、機械特性などを併せ持つため、半導体素子の表面保護膜、層間絶縁膜等に用いられている。最近では、半導体素子の高集積化、大型化に伴い、機械特性、耐熱性等に優れたポリイミド樹脂に対する要求が高くなってきている。

【0003】このようなポリイミド樹脂としては、パターン作成工程が簡略化でき、煩雑な製造工程の短縮が行えるという特徴から、感光性ポリイミド樹脂が多く用いられてきているが、現像の際に有機溶剤を必要とするので、安全性および環境問題の点から課題が残されている。そのため、最近では、アルカリ水溶液で現像が可能な感光性樹脂が提案されている。このようなものとしては、例えば、以下のような技術が知られている。

(1)ポリアミド酸にアミノ基、アミド基、ウレタン基等を有する化合物を混合し、光開始剤の存在下露光後、加熱する方法(特開平6-289626号公報参照)

(2)ポリアミド酸とフェノール性水酸基を有するアミン化合物との塩にキノンジアジドを混合する方法(特開平6-161102号公報参照)

(3)

(3) ポリアミド酸にニフェジピン等の塩基発生剤を混合する方法(特開平5-5995号公報参照) 以上挙げたものは、ポリアミド酸をベースとしたものであるが、これらのものは比較的良好な現像性を示すが、露光部と未露光部の溶解度差をとりにくく、パターンの

あるか、これらのものは比較的良好な現像性を示すか、 露光部と未露光部の溶解度差をとりにくく、パターンの 膜減りが大きい。また、光感度も十分高いとはいいにく い。

【0004】また、ポリベンゾオキサゾール前駆体にジアゾキノン化合物を混合したもの(特公平1-46862号公報参照)や、ポリアミド酸にエステル結合を介しフェノール部位を導入したもの(特開平4-218051)など、カルボン酸の代わりにフェノール性水酸基を導入したもの等が知られているが、これらのものは現像性、光感度が不十分であり、また樹脂の基材からの剥離等の問題がある。

【0005】このような現像性、接着の改良を目的に、 シロキサン部位をポリマー骨格中に有するポリアミド酸 を混合したもの(特開平4-31861号公報、特開平 4-46345号公報等参照)も提案されていが、この ものは現像性は改善されるが、上述のごとく光感度が不 十分である。これに対し、ポリイミド前駆体のカルボキ シル基に特定の保護基を導入した樹脂成分と、活性光線 の照射により酸性を呈する化合物とを配合した化学増幅 型の感光性組成物(特開平4-120171号公報参 照)が提案されている。しかしながら、このものにおい ては保護基としてテトラヒドロピラニル基や1-エトキ シエチル基、メトキシメチル基、トリメチルシリル基等 を保護基とした場合、感度は良好であるが、これらの保 護基は脱離しやすいために、溶液状態での保存安定性の 問題、および露光後の加熱処理(以下PEBと言う。) に至るまでの放置時間あるいはPEB温度によりパター ン形状 (解像性) や感度に大きく影響を与える等、実用 的には不十分なものである。

【0006】また、保護基としてメチル基やエチル基、プロピル基、ブチル基、ベンジル基などを用いた場合、溶液中の保存安定性は向上するが、活性光線の照射による酸発生後、PEB工程を経ても保護基の脱離が十分には起きず、実用レベルの材料とは言えない。

[0007]

【発明が解決しようとする課題】本発明はアルカリ水溶液による現像が可能で、かつ、光感度および解像性に優れた感光性組成物を提供することにある。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明の第一の感光性組成物は、(A)下記一般式(1)で表される構造単位を有するポリアミド酸誘導体100重量部、

[0009]

【化6】

$$\begin{bmatrix}
0 & 0 \\
0 & 1 \\
C & C - NH - R^2 - NH
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
R^3 - C & R^1 & C - R^4 \\
0 & 0
\end{bmatrix}$$
(1)

【0010】(式中、R¹:四価の有機基、R²:二価の有機基、R³、R⁴:一価の有機基又は水酸基を示し、そのうち少なくとも一方は芳香環に結合した水酸基1個以上を有する有機基を示す。)、(B)放射線照射により酸を発生する化合物0.5~20重量部、(C)酸の作用により上記一般式(1)で表される構造単位を有するポリアミド酸誘導体を架橋し得る化合物3~40重量部を含有することを特徴とする感光性組成物である。

【0011】本発明の第二の感光性組成物は、(A)下記一般式(1)で表される構造単位を有するポリアミド酸誘導体と下記一般式(2)で表される構造単位を有するポリアミド酸の混合物100重量部、

[0012]

【化7】

$$\begin{bmatrix}
0 & 0 \\
H & C \\
C & R^3 - C
\end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix}
C - NH - R^2 - NH \\
C - R^4
\end{bmatrix}$$
(1)

【0013】(式中、R1:四価の有機基、R2:二価の有機基、R3、R4:一価の有機基又は水酸基を示し、そのうち少なくとも一方は芳香環に結合した水酸基1個以上を有する有機基を示す。)、

[0014]

【化8】

$$\begin{bmatrix}
0 & 0 \\
0 & 1 \\
C & -NH - R^6 - NH
\end{bmatrix}$$
(2)

【0015】(式中 R^5 は四価の有機基、 R^6 は二価の有機基を示す。)

(B) 放射線照射により酸を発生する化合物 0.5~2 〇重量部、(C)酸の作用により上記一般式(1)で表 される構造単位を有するポリアミド酸誘導体を架橋し得 る化合物 3~40重量部、を含有することを特徴とする 感光性組成物である。

【0016】本発明の第三の感光性組成物は、(A)下記一般式(1)および下記一般式(2)で表される構造単位を含む共重合体構造を有するポリアミド酸誘導体100重量部、

[0017]

【化9】

(4)

特開平10-307393

$$\begin{bmatrix}
0 & 0 \\
0 & 0 \\
C & -NH - R^2 - NH
\end{bmatrix}$$
(1)

【0018】(式中、R1:四価の有機基、R2:二価の有機基、R3、R4:一価の有機基又は水酸基を示し、そのうち少なくとも一方は芳香環に結合した水酸基1個以上を有する有機基を示す。)、

[0019]

【化10】

【0020】(式中R⁵は四価の有機基、R⁶は二価の有機基を示す。)

(B) 放射線照射により酸を発生する化合物0.5~2 0重量部、(C) 酸の作用により上記一般式(1)で表 される構造単位を有するポリアミド酸誘導体を架橋し得 る化合物3~40重量部、を含有することを特徴とする 感光性組成物である。本発明のこれらの感光性組成物 は、基板上に塗布され、所定のパターンを有するマスク を介して露光した後、現像処理することによってパター ニングでき、更に、これを加熱することにより、ポリイ ミド膜パターンを得ることができる。以下、本発明の感 光性組成物について詳細に説明する。

【0021】本発明の感光性組成物の成分は、樹脂成分(以下、A成分という)と感光剤成分(以下、B成分、C成分という)に分けられる。このうち、まず、前記構造単位(1)を共通に含むA成分について説明する。 <A成分>本発明の前記第一の感光性組成物における樹脂成分は、前記構造単位(1)を有するポリアミド酸誘導体である。このポリアミド酸誘導体は、ポリイミドの前駆体であり、代表的には以下の方法によって合成される。

[第一段階]まず、下記一般式(3)に示すテトラカルボン酸二無水物と、芳香環に直接結合した水酸基1個以上を有するアルコール化合物、または同アミン化合物とを、モル比約1:1~2で反応させ、下記一般式(4)の化合物を生成させる。

[0022]

【化11】

[0023]
[
$$1$$
(1 12]

 1 (1 12)

 1 (1 2)

 1 (1 2)

 1 (1 2)

 1 (1 2)

 1 (1 2)

 1 (1 2)

 1 (1 3)

 1 (1 4)

 1 1)

 1 2)

 1 3)

 1 4)

【0024】(ここで、一般式(3)のテトラカルボン酸二無水物及び、式(4)の化合物における R^1 , R^3 , R^4 は、前記構造単位(1)における R^1 , R^3 , R^4 と同義)

[第二段階]前記化合物(4)と、ジアミノ化合物NH $_2$ ーR 2 ーNH $_2$ (R 2 は構造単位(1)におけるR 2 と同義)と、脱水剤とを、モル比約1:1:2 (又は2以上)で、有機溶媒中において反応させる。こうして化合物(4)とジアミノ化合物との縮合反応により、前記構造単位(1)を有するポリアミド酸誘導体が合成される。

【0025】前記第一段階の反応において使用される一 般式(3)のテトラカルボン酸二無水物としては、例え ば、ピロメリット酸二無水物、3,3'、4,4'ーベン ゾフェノンテトラカルボン酸二無水物、1,4,5,8 ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、2,3,6, 7-ナフタレンテトラカルボン酸二無水物、1,2, 5.6ーナフタレンテトラカルボン酸二無水物、3. 3'、4,4'ービフェニルテトラカルボン酸二無水物、 2, 2'、3, 3'-ビフェニルテトラカルボン酸二無水 物、2,3,3'、4'-ビフェニルテトラカルボン酸二 無水物、2,3,3'、4'-ベンゾフェノンテトラカル ボン酸二無水物、2,2-ビス(3,4-ジカルボキシ フェニル)プロパン二無水物、2,2-ビス[5-(3,4-ジカルボキシフェノキシ)フェニル]プロパ ン二無水物、2,2ービス「5ー(2,3ージカルボキ シフェノキシ)フェニル]プロパン二無水物、ビス (3,4-ジカルボキシフェニル]スルホン酸二無水 物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル]エーテル二 無水物、ビス(3,4-ジカルボキシフェニル]メタン 二無水物、ベリレン-3,4,9,10テトラカルボン 酸二無水物、ブタンテトラカルボン酸二無水物、2, 2'-(3,4-ジカルボキシフェニルヘキサフルオロ プロパン二無水物からなる群より選ばれた少なくとも一 種の化合物が使用できる。

【0026】前記第一段階の反応において使用されるアルコール化合物には、式 R^7 -OH(ただし、 R^7 -O-は前記 R^3 または R^4 と同一)で示される化合物が使用できる。この化合物 R^7 -OHにおいて、 R^7 -は、芳香環に結合した水酸基を1個以上有する有機基である。このようなアルコール化合物としては、例えば、2-ヒドロキシベンジルアルコール、3-ヒドロキシベンジルアル

コール、4ーヒドロキシベンジルアルコール、2ーヒドロキシフェニルエチルアルコール、3ーヒドロキシフェニルエチルアルコール、4ーヒドロキシフェニルエチルアルコール、4ーヒドロキシフェニルー3ープロパノール、4ーヒドロキシフェニルー4ーブタノール、ヒドロキシナフチルエチルアルコール等が挙げられる。

【0027】このうち、特に下記一般式(5)で示される化合物が好ましい例として挙げられ、中でも3-ヒドロキシベンジルアルコールが最も好ましい。

[0028]

【化13】

【0029】(ただし、pは正の整数、好ましくは1~4)

前記第一段階の反応において使用されるアミン化合物に は、式R8-N(R9)H(ただし、R8は前記R3または R⁴、R⁹は水素又は一価の有機基)で示される一級ない し二級アミン化合物が使用できる。この一級ないし二級 アミン化合物R8-N(R9)Hにおいて、R8-は、芳 香環に結合した水酸基を1個以上有する有機基である。 このようなアミン化合物としては、例えば、2-アミノ フェノール、3ーアミノフェノール、4ーアミノフェノ ール、4-アミノー4'-ヒドロキシジフェニルエタ ン、4-アミノー4'-ヒドロキシジフェニルエーテ ル、2-(4'-アミノフェニル)-2-(3''-ヒドロキシフェニル)プロパン、2-(4'-アミノフェニ ル)-2-(3"-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオ ロプロパン、2-(3'-アミノフェニル)-2-(3''ーヒドロキシフェニル)プロパン、2-(4'-アミノフェニル) -2-(4"-ヒドロキシフェニル) プロパン、2-(4'-r)ミノフェニル)-2-(4'')-ヒドロキシフェニル) ヘキサフルオロプロパンが挙げ られる。

【0030】このうち、下記一般式(6)で示される化 合物が特に好ましい。

[0031]

【化14】

【0032】(ここで、R⁹は水素又は一価の有機基、qは0以上の整数、好ましくは0~4) この第一段階では、前記二種の化合物を、溶媒を用いないかまたは、適切な溶媒中で、適切な触媒の存在下または、触媒の存在なしに、室温または加熱下(温度範囲:約25~200℃)において反応させる。

【0033】一方、前記第二段階の反応において使用されるジアミノ化合物 ($NH_2-R^2-NH_2$) には、例え

ば、m-フェニレンジアミン、p-フェニレンジアミ ン、2,4-トリレンジアミン、3,3'ージアミノジ フェニルエーテル、3,4'-ジアミノジフェニルエー テル、4,4'-ジアミノジフェニルエーテル、3,3' ージアミノジフェニルスルホン、4,4'ージアミノジ フェニルスルホン、3,4'-ジアミノジフェニルスル ホン、3,3'-ジアミノジフェニルメタン、4,4'-ジアミノジフェニルメタン、3,4'-ジアミノジフェ ニルメタン、4,4'-ジアミノジフェニルスルフィ ド、3、3'ージアミノジフェニルケトン、4、4'ージ アミノジフェニルケトン、3,4'-ジアミノジフェニ ルケトン、2,2'-ビス(4-アミノフェニル)プロ パン、2, 2'ービス(4-アミノフェニル)フェキサ フルオロプロパン、1,3-ビス(3-アミノフェノキ シ)ベンゼン、1,3-ビス(4-アミノフェノキシ) ベンゼン、1,4-ビス(4-アミノフェノキシ)ベン ゼン、4-メチルー2,4-ビス(4-アミノフェニ ル)-1-ペンテン、4-メチルー2,4-ビス(4- α -ジメチルー4-アミノベンジル)ベンゼン、イミノ ージーpーフェニレンジアミン、1,5ージアミノナフ タレン、2,6-ジアミノナフタレン、4-メチルー 2,4-ビス(4-アミノフェニル)ペンタン、5(ま たは6) -アミノ-1 - (4 -アミノフェニル) -1, 3,3-トリメチルインダン、ビス(p-アミノフェニ ル) ホスフィンオキシド、4,4'-ジアミノアゾベン ゼン、4,4'-ジアミノジフェニル尿素、4,4'-ビ ス(4-アミノフェノキシ)ビフェニル、2,2-ビス $2, 2 - \forall x [4 - (4 - r \leq 1) + 2 \leq 1)$ ヘキサフルオロプロパン、2,2ビス[4-(3-アミ ノフェノキシ)フェニル]ベンゾフェノン、4,4'-ビ ス(4-アミノフェノキシ)ジフェニルスルホン、4, 4'- $\forall \lambda (4-(\alpha \alpha - 3) + 3) + (4-\gamma \alpha \alpha - 3) +$ ル)フェノキシ]ベンゾフェノン、4,4'-ビス[4- $(\alpha, \alpha-i)$ x+x-シ]ジフェニルスルホン、ビス(4-アミノフェニル) ジメチルシラン、ビス(4-アミノフェニル) テトラメ チルシロキサン等の芳香族ジアミン、およびこれら芳香 族ジアミンの芳香核の水素原子が、塩素原子、フッ素原 子、臭素原子、メチル基、メトキシ基、シアノ基、フェ ニル基からなる群より選ばれた少なくとも一種の置換基 によって置換された化合物、また3,5-ジアミノー1 ーヒドロキシベンゼン、3,3'ージヒドロキシー4, 4'-ジアミノビフェニル、4,4'-ジヒドロキシー 3, 3'ージアミノビフェニル、2, 2ービス(4ーア ミノー3-ヒドロキシフェニル)プロパン、ビス(3-アミノー4ーヒドロキシフェニル)スルフィド、ビス (3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)スルホン、ビ ス(3-アミノ-4-ヒドロキシフェニル)メタン、ビ

イジンスルホン、2、2ービス(4ーアミノフェノキシフェニル)プロパン、ビス(4ーアミノフェノキシフェニル)スルホン、ビス(4ーアミノフェノキシフェニル)スルフィド、1、4ー(4ーアミノフェノキシフェニル)ベンゼン、1、3ー(4ーアミノフェノキシフェニル)ベンゼン、9、9ービス(4ーアミノフェニル)アントラセン、9、9ービス(4ーアミノフェニル)フルオレン、4、4'ージー(3ーアミノフェノキシ)ジフェニルスルホン、4、4'ージアミノベンズアミリド、および下記一般式(7)に示す化合物からなる群から選ばれた少なくとも一種のジアミノ化合物が使用できる。

[0034]

【0035】(式中1は2~12の整数)

前記第二段階の反応において使用される脱水剤として は、硫酸、塩酸、pートルエンスルホン酸、酢酸コバル ト、酢酸マンガン、塩化第一スズ、塩化第二スズ、ポリ リン酸、亜リン酸トリフェニル、ビスーローフェニレン ホスフェイト、N, N— (フェニルホスフィノ) ビス [2(3H) -ベンゾチアゾロン]、一般式R-N=C= N-R'で示されるカルボジイミド誘導体、例えばジシ クロヘキシルカルボジイミド (DCC) 等が挙げられ る。また、上記構造単位(1)を含む樹脂成分の合成に 用いられる有機溶媒としては、通常、非プロトン性の極 性溶媒が使用されるが、本発明で用いるポリアミド酸誘 導体の合成に関しては、芳香族炭化水素、テトラヒドロ フラン、ジオキサン等の溶媒も使用できる。具体的に は、シクロヘキサノン、アセトン、メチルエチルケト ン、メチルイソブチルケトン等のケトン系溶媒、メチル セロセルブ、メチルセロセルブアセテート、ブチルセロ セルブアセテート、等のセロセルブ系溶媒、酢酸エチ ル、酢酸ブチル、酢酸イソアミル等のエステル系溶媒、 テトラヒドロフラン、ジオキサン等のエーテル系溶媒、 N, N-ジメチルホルムアミド、N, N-ジメチルアセ トアミド(DMAc)、N-メチルー2-ピロリドン (NMP), $N-X \neq \nu - \varepsilon - \tau$ チロラクトン、スルホラン、N, N, N', N'ーテトラ メチル尿素、ヘキサメチルホスホアミド、トルエン、キ シレン等の溶媒からなる群から選ばれた少なくとも一種 の溶媒あるいはそれらの混合溶媒が用いられる。この第 二段階の反応は、冷却下ないし加熱下(温度範囲: -2 0~100℃) において、約30分~24時間、好まし くは約1~8時間行われる。このようにしてポリアミド 酸誘導体が合成される訳であるが、ここでは特に第二段 階で用いられる縮合剤、反応溶媒の選択が重要である。 反応条件が穏和でかつ不純物としてイオン成分を含まな いという観点から、縮合剤としてはDCCが好ましい。 また反応溶媒には、得られるポリマーがゲル化せず、か つ十分な溶解力をもつ点でDMAc、NMP等のアミド 系溶剤が好ましい。以上のように、前記構造単位(1) を有するポリアミド酸誘導体の合成では、まず第一段階 の反応において、カルボン酸に置換基(前記アルコール 化合物、アミン化合物)が導入されたモノマー(カルボ ン酸誘導体)が形成され、次に第二段階の反応におい て、前記モノマーとジアミノ化合物との重縮合により、 側鎖に置換基が導入されたポリマー鎖(ポリアミド酸誘 導体)が形成される。この他にも、まず第一段階でジカ ルボン酸無水物とジアミノ化合物により下記一般式 (8)のポリアミド酸を合成し、次の第二段階でその側 鎖に芳香環に結合した水酸基1個以上を有する有機基を 導入する方法によって合成することも可能である。

【0036】 【化16】

【0037】なお、本発明では、構造単位(1)を有するポリアミド酸誘導体の側鎖に置換基を導入するための化合物(前記第一段階においてテトラカルボン酸二無水物(3)と反応する化合物)として、上述した芳香環に結合した水酸基1個以上を有するアルコール化合物、アミン化合物の他に、分子中に芳香環に結合した水酸基を

含まないアルコール化合物 (含フェノール化合物)、アミン化合物などを併用することもできる。

【0038】このようなアルコール化合物としては、例えば、メタノール、エタノール、1ープロパノール、イソプロピルアルコール、1ーブタノール、2ーブタノール、イソブタノール、tーブタノール、1ーペキサノール、ベンジルアルコール、メチルベンジルアルコール、シンナミルアルコール、メトキシベンジルアルコール、アリルアルコール、2ーヒドロキシエチルメタクリレート等が、またフェノール化合物としては、例えば、フェノール、クレゾール、キシレノール、ブチルフェノール、アリルフェノール、メトキシフェノール等が挙げられる。

【0039】前記アミン化合物としては、例えば、メチルアミン、エチルアミン、プロピルアミン、ブチルアミン、イキシルアミン、アニリン、トルイジン、エチルアニリン、ベンジルアミン等が挙げられる。また、上述したような芳香環に結合した水酸基を含まない化合物またはフェノール化合物を併用する場合、その使用量は、当該置換基を導入するための化合物使用総量の約80モル%以下であることが好ましい。この使用量が80モル%を超えると、感光性組成物の光感度が低下する、また、現像液に対する溶解速度が極端に低下し、形成されるポリイミド膜パターンが劣化する等の問題が起るためである。さらに、より好ましい上記化合物の使用量は60モル%以下である。

【0040】なお、この場合、本発明の感光性組成物の樹脂成分において、上記化合物が導入されてなるポリアミド酸誘導体、及び、前記側鎖に芳香環に結合した水酸基を有する有機基が導入されたポリアミド酸誘導体が、混合物を形成してもよく、また共重合体を形成していてもよい。上記方法によって合成された構造単位(1)を含むポリアミド酸誘導体は、次のように精製される。すなわち、ポリアミド酸誘導体の反応溶液に、メタノール、エタノール、水などを脱水剤に対し、約1~2倍モル添加し、1~4時間撹拌して、未反応の脱水剤を反応させて沈殿を沪過して系外に除去し、得られた溶液を、反応溶液の5~100倍のメタノール、エタノール、または、水により洗浄する。この後、真空中において室温~60℃で乾燥させることにより、ポリアミド酸誘導体を単離精製させる。

【0041】本発明の第二の感光性組成物における樹脂成分は、前記構造単位(1)を有するポリアミド酸誘導体、及び、前記構造単位(2)を有するポリアミド酸の混合物である。このうち、前記構造単位(1)を有するポリアミド酸誘導体は、上述した第一の感光性組成物におけるポリアミド酸誘導体と同様の方法に従い、同様の化合物を使用して合成できる。

【0042】また、前記構造単位(2)を有するポリア ミド酸はテトラカルボン酸二無水物(3)と、ジアミノ 化合物($NH_2-R^2-NH_2$)とを、適切な溶媒中で室温又は $-20\sim20$ °、好ましくは $-5\sim10$ °Cの冷却下で反応させることにより合成できる。この反応に使用されるテトラカルボン酸二無水物(3)、ジアミノ化合物($NH_2-R^2-NH_2$)、及び溶媒には、前記構造単位(1)を有するポリアミド酸誘導体の合成に使用できる化合物であればよい。

【0043】また、当該第二の感光性組成物の樹脂成分における、前記構造単位(1)を有するポリアミド酸誘導体、及び前記構造単位(2)を有するポリアミド酸の成分比率は、全樹脂成分を100重量部として、前記ポリアミド酸誘導体20~98重量部が好ましく、更に好ましくは40~95重量部である。前記ポリアミド酸誘導体が20重量部未満であれば、該感光性組成物を使用してフォトリソグラフィー技術等によりポリイミド膜パターンを形成する場合、露光部及び未露光部ともに現像液に対する溶解速度が増し、目的のレリーフ像のコントラストが低下する。また、前記ポリアミド酸を2重量部以上(前記ポリアミド酸誘導体が98重量部以内)用いるのは、塗膜の現像性を向上させ、強い現像液を用いなくてもよい等の理由からである。

【0044】なお、当該第二の感光性組成物における樹脂成分としては、前記第一の感光性組成物と同様に、側鎖に芳香環に結合した水酸基を含まない置換基が導入されたポリアミド酸誘導体を含有させてもよい。本発明の第三の感光性組成物における樹脂成分は、前記構造単位(1)及び前記構造単位(2)を含む共重合体構造のポリアミド酸誘導体である。この共重合体構造のポリアミド酸誘導体は、上述した第一の感光性組成物におけるポリアミド酸誘導体の合成方法と、類似した方法によって合成できる。

(共重合体構造ポリアミド酸誘導体の合成方法)まず、第一段階として、テトラカルボン酸二無水物(3)と、芳香環に結合した水酸基1個以上を有するアルコール化合物、同アミン化合物とを、モル比1:1~2で反応させ、前記化合物(4)を合成させる。この反応は、前記二種の化合物を、溶媒を用いず、又は適切な溶媒中で、室温又は加熱下で行われる。

【0045】次に、第二段階として、前記化合物(4) と、ジアミノ化合物($NH_2-R^2-NH_2$)と、脱水剤とを、モル比s:(s+t):2s(s,tは正の整数)で前記溶媒中で反応させる。この反応は、冷却下ないし加熱下において、約 $1\sim8$ 時間、好ましくは4時間以上行われる。さらに第三段階として、上記溶液にテトラカルボン酸二無水物(3)を t モル加え、 $0\sim20$ で約 $1\sim8$ 時間、好ましくは4 時間以上反応させる。

【0046】こうして、前記構造単位(1)及び前記構造単位(2)を含む共重合体構造のポリアミド酸誘導体を合成できる。上記の本発明の第三の感光性組成物における樹脂成分の合成で使用される、テトラカルボン酸二

無水物(3)、芳香環に結合した水酸基 1 個以上を有するアルコール化合物、同アミン化合物、ジアミノ化合物($NH_2-R^2-NH_2$)、脱水剤、及び各溶媒は、前記第一及び第二の感光性組成物における樹脂成分の合成で使用される化合物であればよい。

【0047】また、当該第三の感光性組成物における樹脂成分の合成では、前記第一の感光性組成物と同様に上記のような芳香環に結合した水酸基1個以上を有するアルコール化合物、アミン化合物とともに、芳香環に結合した水酸基を含まないアルコール化合物、アミン化合物を併用することもできる。上記樹脂成分の共重合体構造における、前記構造単位(1)及び前記構造単位(2)の比(s/t)は、使用される樹脂原料によって、最終樹脂特性が異なるため、特に限定された値はとらないが、1~20となることが好ましい。1より小さいと、アルカリ現像液に対する溶解性が大きくなり、現像時に露光部及び未露光部の現像液に対する十分な溶解度差が得られない。逆にtの値が小さくなりs/tが20より大きくなると、塗膜の溶解性が不足し現像性が不十分になる。

【0048】このようにして得られる第一および第二の感光性組成物に用いられる前記一般式(1)の構造単位を有するポリアミド酸誘導体、並びに第三の感光性組成物に用いられる前記一般式(1)と(2)の構造単位を有する共重合体の分子量は、還元粘度(濃度=ポリマー:1g/NMP:100mL、30℃)で0.15~0.6[dL/g]、好ましくは0.25~0.5[dL/g]である。また第二の組成物に用いられる前記式(2)の重合体では0.3~0.8である。

<B成分>次に、本発明の耐熱性感光性組成物の(B)成分について説明する。本発明に使用される(B)成分は、前記第一、第二、第三の組成物に関して共通であり、放射線照射により酸を発生する化合物である。このような化合物としては、例えば、以下の化合物が挙げられる。

i)トリクロロメチルーsートリアジン類:トリス (2, 4, 6-トリクロロメチル)-sートリアジン、2ーフェニルービス (4, 6-トリクロロメチル)-sートリアジン、2ートリアジン、2ー(4, 6-トリクロロメチル)-sートリアジン、2ー(2-クロロフェニル)-ビス(4, 6-トリクロロメチル)-sートリアジン、2ー(2-クロロフェニル)ービス(4, 6-トリクロロメチル)-sートリアジン、2ー(4, 6-トリクロロメチル)-sートリアジン、2ー(2-メトキシフェニル)-ビス(4, 6-トリクロロメチル)-sートリアジン、2ー(2-メトキシフェニル)-ビス(4, 6-トリアジン、2ー(4, 6-トリクロロメチル)ーsートリアジン、2ー(3-メチルチオフェニル)ビス(4, 6-トリクロロメチル)-sートリアジン、2ー(3-メチルチオフェニル)ビス(4, 6-トリクロロメチル)コェートリアジン、2ー(2-メチルチオフェ

ニル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ーsートリアジン、2ー(4ーメトキシナフチル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ーsートリアジン、2ー(2ーメトキシナフチル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ーsートリアジン、2ー(3,4,5ートリメトキシー β ースチリル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ーsートリアジン、2ー(4ーメチルチオー β ースチリル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ーボス(4,6ートリクロロメチル)ーボス(4,6ートリクロロメチル)ーsートリアジン、2ー(2ーメチルチオー β ースチリル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ービス(4,6ートリクロロメチル)ーsートリアジン等。

i i) ジアリルヨードニウム類: ジフェニルヨードニウ ムテトラフルオロボレート、ジフェニルヨードニウムテ トラフルオロホスフェート、ジフェニルヨードニウムテ トラフルオロアルセネート、ジフェニルヨードニウムト リフルオロメタンスルホナート、ジフェニルヨードニウ ムトリフルオロアセテート、ジフェニルヨードニウムー p-トルエンスルホナート、4-メトキシフェニルフェ ニルヨードニウムテトラフルオロボレート、4-メトキ シフェニルフェニルヨードニウムヘキサフルオロホスホ ネート、4-メトキシフェニルフェニルヨードニウムへ キサフルオロアルセネート、4-メトキシフェニルフェ ニルヨードニウムトリフルオロメタンスホナート、4-メトキシフェニルフェニルヨードニウムトリフルオロア セテート、4-メトキシフェニルフェニルヨードニウム ーpートルエンスルホナート、ビス(4-terーブチル フェニル) ヨードニウムテトラフルオロボレート、ビス (4-terーブチルフェニル) ヨードニウムヘキサフル オロアルセネート、ビス(4-terーブチルフェニル) ヨードニウムトリフルオロメタンスルホナート、ビス (4-terーブチルフェニル) ヨードニウムトリフルオ ロアセテート、、ビス(4-terーブチルフェニル)ヨ 、ードニウムーロートルエンスルホナート等。

iii)トリアリルスルホニウム塩類:トリフェニルスルホニウムテトラフルオロボレート、トリフェニルスルホニウムへキサフルオロホスホネート、トリフェニルスルホニウムへキサフルオロアルセネート、トリフェニルスルホニウムメタンスルホナート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロアセテート、トリフェニルスルホニウムトリフルオロアセテート、4ーメトキシフェニルジフェニルスルホニウムへキサフルオロホスホネート、4ーメトキシフェニルジフェニルスルホニウムペキサフルオロアルセネート、4ーメトキシフェニルスルホニウムトリフルオロアセテート、4ーメトキシフェニルジフェニルスルホニウムトリフルオロアセテート、4ーメトキシフェニルジフェニルスルホニウムトリフルオロアセテート、4ーメトキシフェニルジフェニルスル

ホニウムーゥートルエンスルホナート、4-フェニルチオフェニルジフェニルテトラフルオロボレート、4-フェニルチオフェニルジフェニルへキサフルオロホスホネート、4-フェニルチオフェニルジフェニルへキサフルオロアルセネート、4-フェニルチオフェニルジフェニルトリフルオロメタンスルホナート、4-フェニルチオフェニルジフェニルトリフルオロアセテート、4-フェニルチオフェニルジフェニル・リフルオロアセテート、4-フェニルチオフェニルジフェニルーpートルエンスルホナート等。

【0049】これらの化合物の内、トリクロロメチルー S-トリアジン類としては、2-(3-クロロフェニル)-ビス(4,6-トリクロロメチル)-S-トリアジン、2-(4-クロロフェニル)-ビス(4,6-トリクロロメチル)-S-トリアジン、2-(4-メチル チオフェニル)-ビス(4,6-トリクロロメチル)-S-トリアジン、2-(4-メトキシー $\beta-$ スチリル)-ビス(4,6-トリクロロメチル)-S-トリアジン、2-(4- メトキシナフチル)-ビス(4,6-トリクロロメチル)-ビス(4,6-トリクロロメチル)-ビス(4,6-トリクロロメチル)-ビス(4,6-トリクロロメチル)-S-トリアジン等を、ジアリールヨードニウム塩類としては、ジフェニルヨードニウムトリ

フルオロアセテート、ジフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホナート、4ーメトキシフェニルフェニルヨードニウムトリフルオロメタンスルホナート、4ーメトキシフェニルフェニルヨードニウムトリフルオロア・ニウムトリアリールスルホニウム塩類としては、トリフェニルスルホニウムメタンスルホナート、4ーメトキシフェニルジフェニルスルホニウムメタンスルホナート、4ーメトキシフェニルジフェニルスルホニウムメクンスルホナート、4ーメトキシフェニルジフェニルチオフェニルジフェニルチオフェニルジフェニルチオフェニルジフェニルチオフェニルジフェニルチオフェニルジフェニルチオフェニルジフェニルトリフルオロアセテート等を好適なものとして挙げることができる。

【0050】またこの他に、以下に示す化合物も用いる ことができる。

(1)トリハロメチル基で置換されたオキサジアゾール 誘導体。

【0051】 【化17】

$$CH_{3}O \longrightarrow CH = CH - \frac{N}{C} - CC I_{3}$$

$$CH_{3}O \longrightarrow CH = CH - \frac{N}{C} - CC I_{3}$$

$$CH_{3}O \longrightarrow CH = CH - \frac{N}{C} - CC I_{3}$$

$$CH_{3}O \longrightarrow CH = CH - \frac{N}{C} - CC I_{3}$$

$$CH_{3}O \longrightarrow CH = CH - \frac{N}{C} - CC I_{3}$$

【0052】(2)ジスルホン誘導体。

[0053]

【化18】

(10)

特開平10-307393

【0054】(3)イミドスルホネート誘導体。 【0055】 【化19】

$$H_3C - O - SO_2 - SO_2 - O + CH_3$$
,

【0056】(4) ニトロベンジル誘導体。

【化20】

[0057]

【0058】(ここでR12はアルキル基を表し、炭素原子数1~4のアルキル基、例えば、メチル基、エチル基、n-プロピル基、n-ブチル基等を表す。)これら放射線照射により酸を発生する化合物の添加量は、重合体100重量部に対して、好ましくは0.5~20重量部である。添加量が0.5重量部より少ないと、放射線照射により発生する酸の量が少ないため、感

度が低下する。また、添加量が20重量部を超えるとキュア後の機械物性などの低下を招く恐れがある。 【0059】また、放射線照射により酸を発生する化合物は、増感剤と組み合わせて適宜使用することもできる。このような増感剤としては、例えば、3-位及び/または7-位に置換基を持つクマリン類、フラボン類、

ジベンザルアセトン類、ジベンザルシクロヘキサン類、

カルコン類、キサンテン類、チオキサンテン類、ポルフィリン類、フタロシアニン類、アクリジン類、9-位に 置換基を有するアントラセン類などが挙げられる。

<C成分>次に、本発明の組成物の(C)成分について説明する。本発明に使用される(C)成分は、N位がメチロール基及び/又はアルコキシメチル基で置換されたメラミン樹脂、尿素樹脂から選ばれる。これらの例としては、メラミン樹脂、ベンゾグアナミン樹脂、グリコールウリル樹脂、尿素樹脂、アルコキシメチル化メラミン樹脂、アルコキシメチル化グリコールウリル樹脂、アルコキシメチル化グリコールウリル樹脂、アルコキシメチル化ベンゾグアナミン樹脂、アルコキシメチル化ベングアナミン樹脂、アルコキシメチル化グリコールウリル樹脂、アルコキシメチル化ズンゾグアナミン樹脂、メチロール化ベンゾグアナミン樹脂、メチロール化ベンゾグアナミン樹脂、メチロール化ベンゾグアナミン樹脂、メチロール化ズンブグアナミン樹脂、メチロール化ズンブグアナミン樹脂、メチロール化ズンブグアナミン樹脂、メチロールとマンズクアナミン樹脂、メチロールとマンズクアナミン樹脂、メチロールとマンズクアナミン樹脂、メチロールとマンズクアナミン樹脂、メチロールとマンズクアナミン樹脂、メチロールとマンズクアカミンスクロール基をアルコキシメチル基に変換することにより得られる。

【0060】このアルコキシメチル基の種類については、例えば、メトキシメチル基、エトキシメチル基、プロポキシメチル基、ブトキシメチル基などを挙げることができるが、実用上市販されているサイメル300、301、303、370、325、327、701、266、267、238、1141、272、202、1156、1158、1123、1170、1174、うFR65、300[三井サイアナミッド(株)製]、ニカラックMX-750、-032、-706、-708、-40、-31、ニカラックMS-11、ニカラックMW-30(三和ケミカル社製)等を好ましく使用することができる。これらの化合物は単独でまたは混合して使用することができる。

【0061】この他架橋剤として、前記記載の樹脂の単 量体も用いられ、例えばヘキサメトキシメチルメラミ ン、ジメトキシメチル尿素等を挙げることができる。こ れら酸の作用により、架橋しうる化合物の添加量は、重 合体100重量部に対して、好ましくは、3~40重量 部である。添加量が3重量部より少ないと架橋が不十分 で、パターニングが困難となる恐れがある。また、40 重量部を超えると、組成全体のアルカリ溶解性が高くな りすぎるため、現像後の残膜率が低下するあるいは、キ ュア後の機械物性を低下させる傾向がある。本発明の組 成物は、(A)成分のポリマーを溶剤に溶解しワニス状 にして使用される。溶剤としては、NMP、DMAc、 γ -ブチロラクトン、シクロペンタノン、シクロヘキサ ノン、ジメチルスルホキシド、ジエチレングリコールジ メチルエーテル、ジエチレングリコールジエチルエーテ ル、ジエチレングリコールジブチルエーテル等を単独で も混合して用いてもよい。また、塗布性を改良する目的 で上記の溶剤にプロピレングリコールモノメチルエーテ ル、ジプロピレングリコールモノメチルエーテル、プロ

ピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、乳酸 メチル、乳酸エチル、乳酸ブチル、メチルー1,3ーブ チレングリコールアセテート、1,3-ブチレングリコ ールー3ーモノメチルエーテル、ピルビン酸メチル、ピ ルビン酸エチル、メチルー3-メトキシプロピオネート 等の溶剤を混合して用いることもできる。なお、この際 に基材との接着性を高める為にシランカップリング剤な どの添加剤を添加することもできる。次に、このように して得られた耐熱性感光性組成物を用いて画像を形成す る方法の一例を示す。まず、この組成物ワニスを基材上 に乾燥後の膜厚が1~50µm、好ましくは5~30µ mとなるように塗布する。この時、あらかじめ基材上に シランカップリング剤等の接着助剤を処理をすることも 可能である。塗布した塗膜を乾燥した後、通常のフォト マスクを通して露光を行ない、その後加熱処理(PE B)を行う。このPEB工程は、本組成物の感度を増感 するための処理であり、本発明の目的を達成するために は必要不可欠である。この処理温度は、感度や得られる パターン形状等を考慮すると、90~160℃、好まし くは100~150℃の温度がよい。放射線照射後加熱 処理された基板は、適当な濃度のアルカリ水溶液で現像 処理されることにより基板上に微細な樹脂パターンを転 写することができる。このときに用いる現像液として は、露光膜を適当な時間内で完全に溶解除去できるもの が好ましく、水酸化ナトリウム、水酸化カリウムなどの 無機アルカリ性水溶液、またはプロピルアミン、ブチル アミン、モノエタノールアミン、テトラメチルアンモニ ウムハイドロオキサイド (TMAH)、コリンなどの有 機アルカリ性水溶液などを単独もしくは二種以上混合し て用いる。また、このアルカリ性水溶液には必要に応じ てアルコール類などの有機溶剤や、各種界面活性剤を含 有させることもできる。現像後、リンス液で洗浄するこ とにより耐熱性材料前駆体のネガ型画像が得られる。こ のようにして得られた画像は、高温加熱処理(約200 ~400℃) することによって、耐熱性、耐薬品性、機 械的物性に優れた耐熱性材料に変換することができ、良 好なレリーフパターンを有する硬化物となる。

[0062]

【発明の実施の形態】以下、発明の具体的な実施の形態 を実施例にもとづいて説明する。

[0063]

【実施例1】ベンゾフェノンテトラカルボン酸二無水物(BTDA)68.9重量部(0.21モル)、3-ヒドロキシベンジルアルコール(3HBA)52.1重量部(0.42モル)をN,N'ジメチルアセトアミド(DMAc)750重量部に溶解し、ピリジン33.3重量部(0.42モル)加えた後、16時間室温で撹拌しエステル化を行った。その後、氷冷下でまずジシクロヘキシルカルボジイミド(DCC)86.7重量部(0.42モル)をDMAc80gに溶解したものを滴下し、次に

 $4 \cdot 4' - i r \leq 1 i r \leq 1 i r \leq 1 \cdot 4 \cdot 4' - i r \leq$ 0重量部(0.19モル)をDMAc100gに溶解し たものを加え反応を行った。その後、室温に戻し3時間 反応させ最後にエタノールを加え更に1時間撹拌した 後、不溶分をろ過により除去した後、この反応液を蒸留 水10リットルに滴下し、沈殿物を沪別して集め、減圧 乾燥することによってポリアミド酸エステル (ポリマー 1)を得た。このポリマーの還元粘度(濃度=ポリマ -:1g/NMP:100mL、30℃)は、0.35 [dL/g]であった。次に、このポリマー1:100重 量部に対しNMP:250重量部に溶解し、成分(B) として2-(4-メトキシ-β-スチリル)ービス (4、6-トリクロロメチル)-s-トリアジン:2重 量部および成分(C)としては[三井サイアナミッド (株) 社製サイメル300]: 15重量部を混合させた 後、0.2μmのテフロンフィルターで沪過し、感光性 ワニスを得た。該ワニスをシランカップリング剤であら かじめ処理したシリコンウェハー上にスピンコートし て、乾燥後膜厚5μmの塗膜を得た。この塗膜を、パタ ーンが描かれたマスクを通して超高圧水銀灯を用いて紫 外光線を露光量を変化させて照射した。露光後前記シリ コンウェハーを120℃のホットプレート上で5分間加 熱した。この後10%のTMAH水溶液に10分浸漬す ることによって露光部を溶解除去した後、水でリンスし た。その結果、露光量100mJ/cm2の照射で1µm のライン&スペースが解像され、良好なパターンを得る ことができた。

[0064]

【実施例2】BTDA:38.7重量部(0.12モル) をNMP:200重量部に加え、これにODA:20. 0重量部(0.1モル)、ビス $(\gamma - \gamma \leq 1)$ プロピル) テトラメチルジシロキサン2.5重量部(0.01)を氷 冷下加えた後、室温で10時間反応させた。これによっ て得られたポリアミド酸(ポリマー2)の還元粘度は 0.55であった。次に、このポリマー2の溶液:20 重量部にポリマー1:18重量部をNMP35重量部に 溶解したものを混合し、更に実施例1で用いたのと同じ 成分(B)、(C)をそれぞれ0.36重量部および2. 7重量部を加え、よく混合した。次にこれを0.2μm 、 のテフロンフィルターで沪過し、感光性ワニスを得た。 【0065】該ワニスをシリコンウェハー上にスピンコ ートして、乾燥後膜厚8μmの塗膜を得た。この塗膜 を、パターンが描かれたマスクを通して超高圧水銀灯を 用いて紫外光線を露光量を変化させて照射した。露光後 前記シリコンウェハーを150℃のホットプレート上で 5分間加熱した。この後3%のTMAH水溶液に8分浸 漬することによって露光部を溶解除去した後、水でリン スした。その結果、露光量150mJ/cm²の照射で 2μmのライン&スペースが解像され、良好なパターン

を得ることができた。

[0066]

【実施例3】BTDA:40重量部(0.12モル)、 3HBA: 30重量部(0.24モル)をDMAc:1 00重量部に溶解し、ピリジン:19重量部(0.24 モル)加えた後、16時間室温で撹拌しエステル化を行 った。その後、氷冷下でまずODA:30重量部(0. 15モル)をDMAc:60重量部に溶解したものを加 え、その後DCC: 49.5重量部(0.24モル)をD MAc:50重量部に溶解したものを滴下した。その 後、室温に戻し3時間反応させた後、BTDA:9.7 重量部(0.03モル)を徐々に加え更に3時間反応さ せた。その後不溶分をろ過により除去した後、この反応 液を蒸留水10リットルに滴下し沈殿物を沪別して集 め、減圧乾燥することによって共重合体構造を有するポ リアミド酸エステル(ポリマー3)を得た。このポリマ ーの還元粘度 (濃度=ポリマー: 1g/NMP: 100 mL、30℃) は、0.25[dL/g]であった。次 に、このポリマー3:100重量部をNMP:180重 量部に溶解し、更に実施例1で用いたのと同じ成分 (B)、(C)をそれぞれ3重量部および15重量部を 加え、よく混合した。次にこれを O.2 μmのテフロン フィルターで沪過し、感光性ワニスを得た。該ワニスを あらかじめシランカップリング剤で処理されたシリコン ウェハー上にスピンコートして、乾燥後膜厚5μmの塗 膜を得た。この塗膜を、パターンが描かれたマスクを通 して超高圧水銀灯を用いて紫外光線を露光量を変化させ て照射した。露光後前記シリコンウェハーを120℃の ホットプレート上で5分間加熱した。この後3%のTM AH水溶液に3分浸漬することによって露光部を溶解除 去した後、水でリンスした。その結果、露光量100m J/c m²の照射で1μmのライン&スペースが解像さ れ、良好なパターンを得ることができた。

[0067]

【比較例1】ポリマー2:100重量部を用いる以外は、実施例1と同様にして感光性ワニスを調整し、パターニング性能を調べた。その結果、アルカリ現像性は向上したものの、露光部と未露光部の溶解性の差が取れず、いかなるPEB条件や現像条件においてもすべてパターンが流れてしまった。このことから、この感光性組成物には、フェノール性水酸基を有するポリマーが必須であることが分かる。

[0068]

【発明の効果】本発明により、アルカリ水溶液による現像が可能で、かつ、光感度および解像性に優れた感光性組成物が提供され、本発明の感光性組成物を加熱硬化させることにより、耐熱性の優れた良好なポリイミド膜パターンが得られる。